

Tabela 3. Pomiar charakterystyk wyjściowych w układzie OE:

$$I_C = f(U_{CE}) \text{ przy } I_B = \text{const.}$$

$I_{B(1)} = \dots\dots\dots$		$I_{B(2)} = \dots\dots\dots$		$I_{B(3)} = \dots\dots\dots$	
I_C [mA]	U_{CE} [V]	I_C [mA]	U_{CE} [V]	I_C [mA]	U_{CE} [V]

Opracowanie wyników.

1. Wykreślić rodziny zmierzonych charakterystyk statycznych badanego tranzystora . Każda rodzina charakterystyk w oddzielnej ćwiartce układu współrzędnych.
2. W oparciu o zdjęte charakterystyki, obliczyć w wybranych punktach pracy (min. trzech) rezystancje statyczne R_{we} i R_{wy} oraz dynamiczne r_{we} i r_{wy} .
3. Wyznaczyć współczynniki wzmocnienia prądowego oraz β .
4. Wykreślić na wspólnym wykresie przebiegi zmian obliczonych parametrów.

Do sprawozdania należy dołączyć sporządzone wykresy, przykładowe obliczenia oraz wnioski.